МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №7

по теме: «ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР»

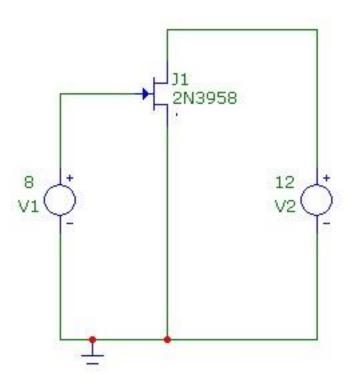
Работу выполнил: студент группы ИУ7-33Б Артемьев Илья Работу проверил: Оглоблин Д.И.

Цель работы:

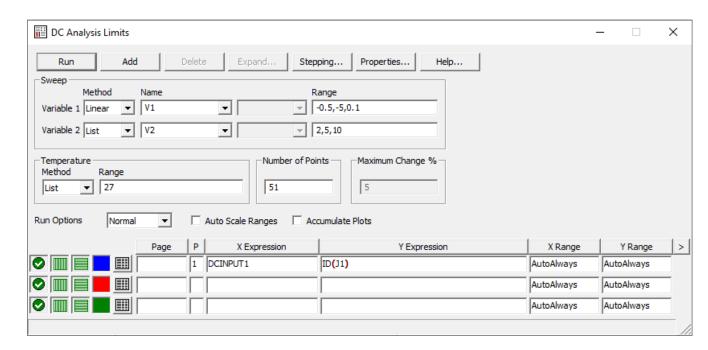
Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Місгосар и знания при исследовании и настройке усилительных и ключевых устройств на биполярных и полевых транзисторах.

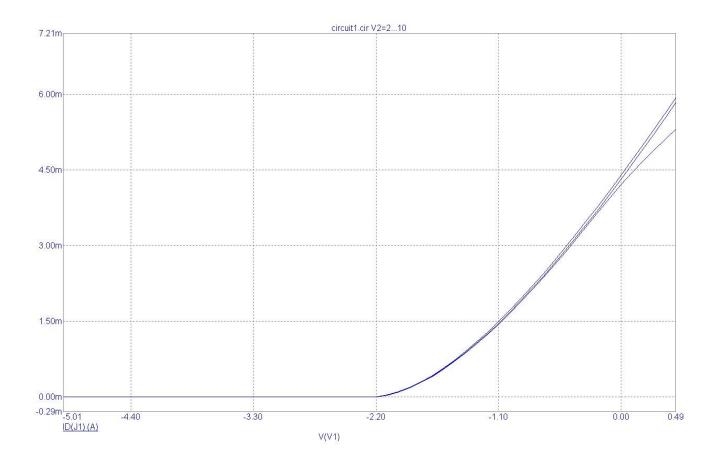
Эксперимент 7

NJFET транзистор – 2N3958



Передаточная характеристика:



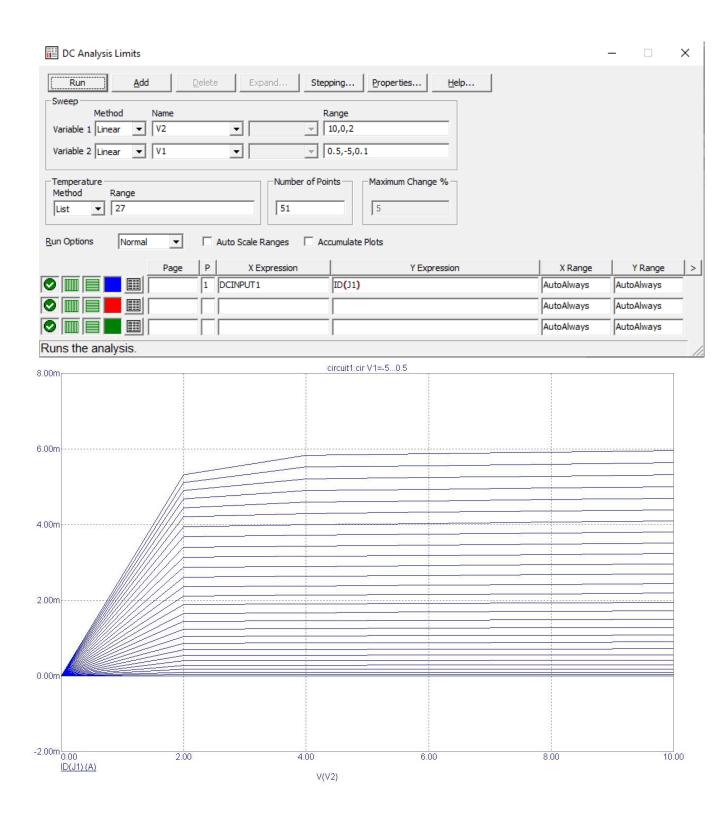


На графике видно, что Uoтc = 2.2B. Расчет крутизны транзистора:

Smax = 2 * Інач / Uотс

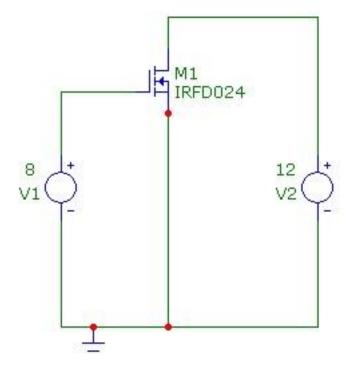
U	Інач	Smax
2	4.198mA	3.82mA
5	4.307mA	3.92mA
10	4.396mA	3.99mA

Выходная характеристика:

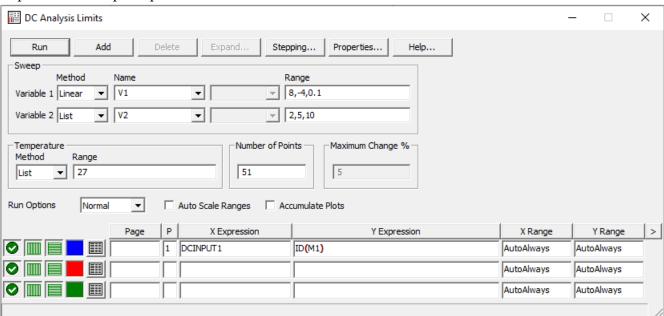


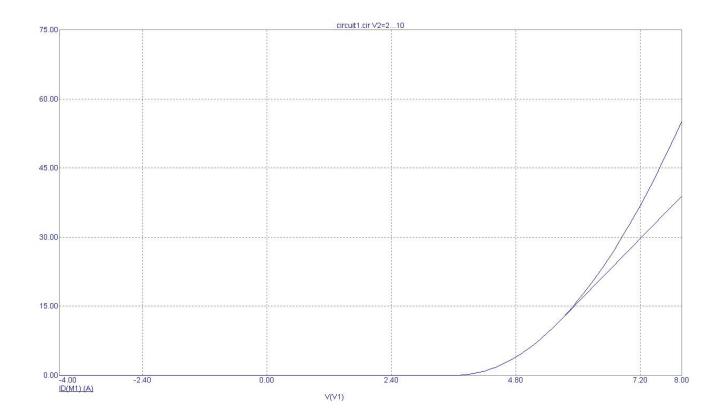
Из графика видно, что крутая область идет на промежутке от 0B до 4B, дальше идет область насыщения.

NMOS транзистор – IRFD024

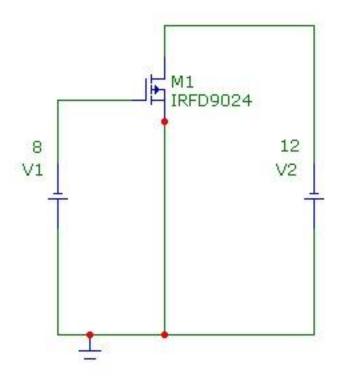


Передаточная характеристика:

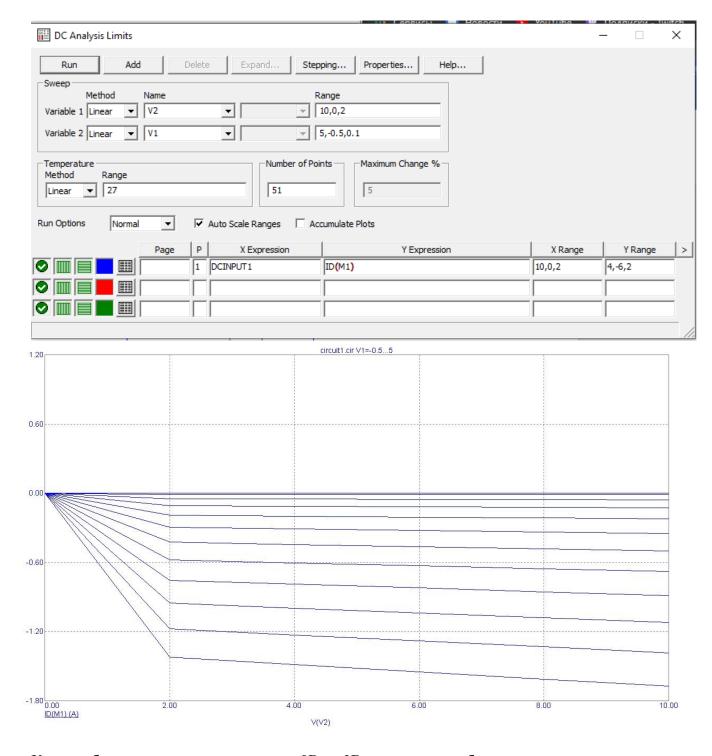




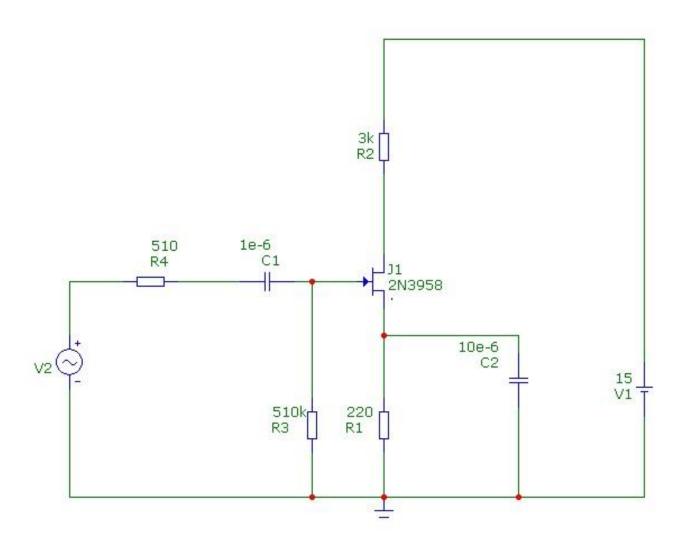
PMOS транзистор – IRFD9024

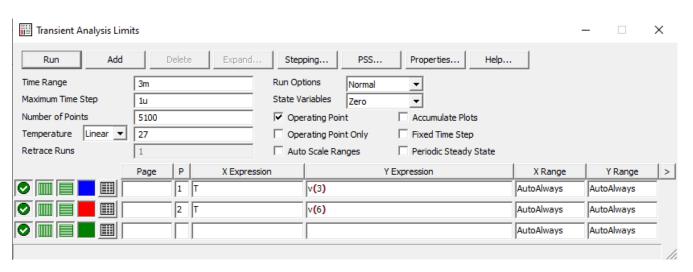


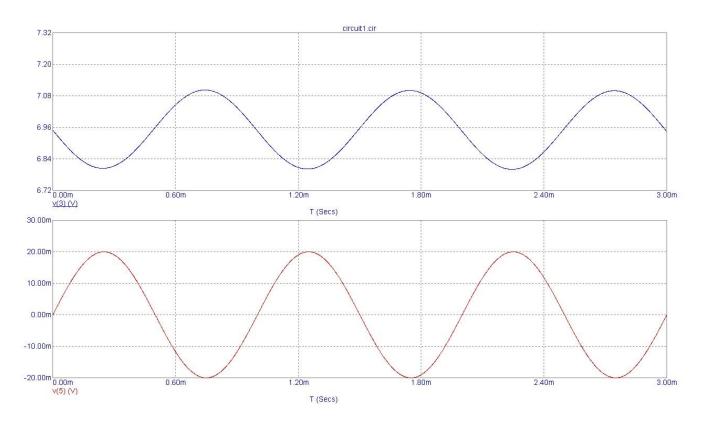
Выходная характеристика:



Крутая область идет на промежутке от 0В до 2В, дальше идет область насыщения







Коэффициент усиления по напряжению:

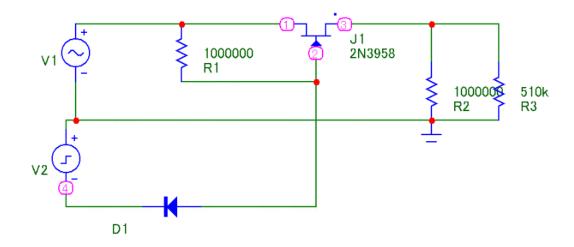
$$M1 = 7.102 - 6.801 = 0.301$$

$$M2 = 20m + 20m = 40m$$

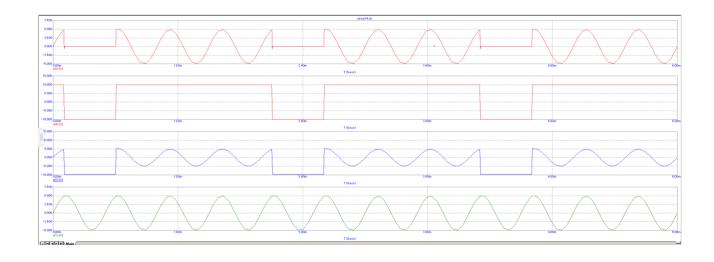
$$M = M1 / M2 = 7.525$$

Эксперимент 8

Соберем схему ключа с управляющим р-п переходом.

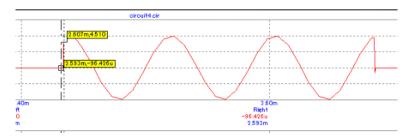


Определим входной и выходной сигналы:



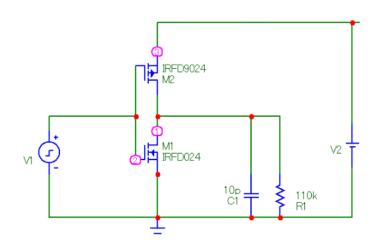
Ключ закрыт при управляющем сигнале -10, диод пропускает ток. При нулевом входном сигнале транзистор заперт. Когда значение входного напряжения превышает пороговое напряжение, транзистор открывается.

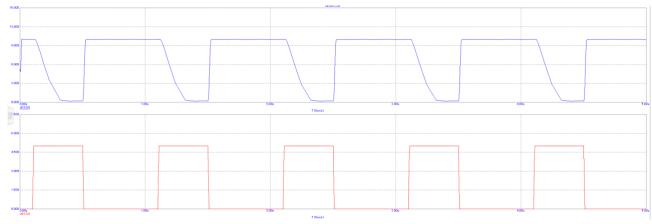
В закрытом состоянии 0. В открытом 10.



Величина выброса 4,5

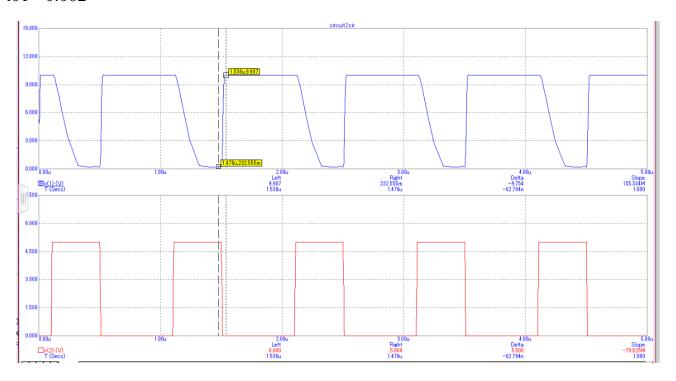
Соберем схему КМОП цифрового ключа.



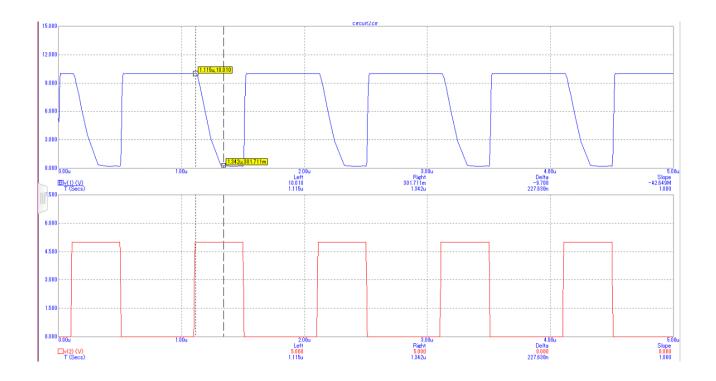


Посчитаем задержку

t01 = 0.062



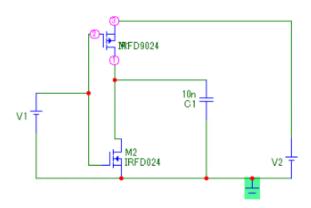
t10 = 0.227

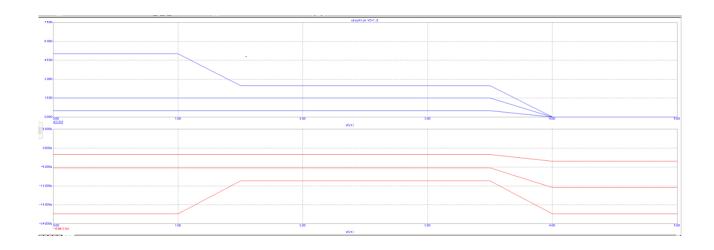


$$t$$
зад = $(t01+t10)/2$

$$t$$
зад = 0.144

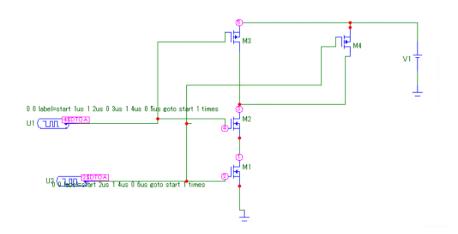
Получим передаточную характеристику для схемы:

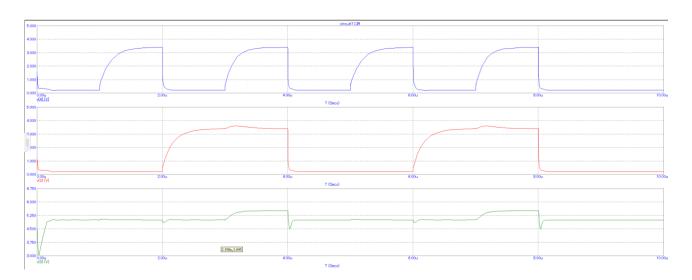




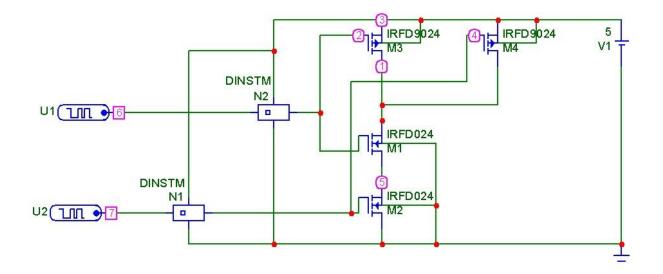
Входное напряжение, при котором открываются транзисторы: 1В

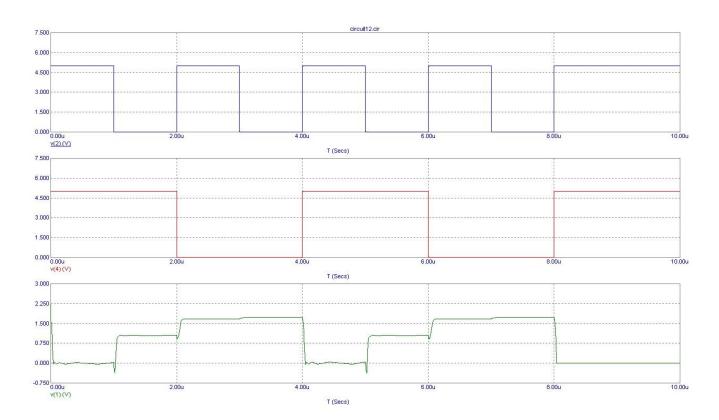
Соберем стенд для исследования работы логического элемента 2И-НЕ.





Поскольку данные полученной характеристики не удовлетворяют эксперименту, добавим в схему DtoA устройства:





Эксперимент 9

"Устройство триггера ячейки статической памяти"

